



На час створення Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України в жовтні 1960 року на базі підрозділів Інституту фізики АН УРСР вже склалися відомі наукові школи з фізики нерівноважних процесів у напівпровідниках і теорії напівпровідників на чолі з видатними вченими В.Є. Лашкарьовим та С.І. Пекарем. Згодом широкого визнання набули наукові школи з оптики і спектроскопії (академік НАН України М.П. Лисиця), оптоелектроніки (академік НАН України С.В. Свечніков), фізики поверхні і мікроелектроніки (академік НАН України О.В. Снітко, д.ф.-м.н. В.І. Ляшенко).

За роки своєї діяльності вчені Інституту стали авторами багатьох видатних наукових результатів та практичних розробок.

Надзвичайно важливе значення для розвитку фізичної науки мали наукові відкриття властивості анізотропії електропровідності напівпровідникових кристалів в сильних електричних полях, явищ поширення додаткових хвиль та комбінованого резонансу в кристалах.

Колективу Інституту завжди було притаманне тісне поєднання фундаментальних наукових досліджень з практичним використанням їх результатів для вирішення актуальних народногосподарських проблем.

Саме в цьому Інституті були вперше запропоновані і реалізовані ефективні форми співпраці з промисловістю, які отримали назву міжгалузевих лабораторій і згодом були поширені на інші наукові установи Національної академії наук України.

Для успішного розвитку космічної тематики в Інституті було вирішено проблему створення точних і надійних засобів контролю наднизьких температур, здатних працювати в екстремальних умовах. Подальший розвиток цих робіт дозволив створити широку гаму сенсорних систем і пристроїв різноманітного призначення.

Слід відзначити також визначальний вклад вчених Інституту в розробку фотоелектричних систем електрозабезпечення космічних апаратів класу «Мікросупутник» та започаткування нової наукової галузі - космічного фотоелектричного приладобудування.

Велике наукове і практичне значення мають роботи з інфрачервоної мікрофотоелектроніки, результати яких використовуються в інтересах медицини, біології, екології, оборони.

Інститут є головною організацією Наукової ради з проблеми «Фізика напівпровідників та напівпровідникові пристрої», засновником Технологічного парку «Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка». При Інституті діє СКТБ з дослідним виробництвом.

Активно розвивається науково-технічне співробітництво з рядом провідних вітчизняних і зарубіжних науково-технічних центрів та університетів, протягом багатьох років видається наукова періодика, успішно працює аспірантура і докторантура. Приємно відзначити, що сьогодні в особі Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України ми маємо сучасну академічну науково-дослідну установу зі своїми традиціями, актуальною тематикою та потужним науковим кадровим потенціалом, колектив якого по праву користується широким визнанням наукової спільноти в країні та світі.

Президент НАН України
академік НАН України

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.Є. Патон'.

Б.Є. Патон